24 pWB-2

## 成長機構とカイラリティ制御

東大エ

丸山 茂夫

Growth Mechanism and Chirality Control

Univ. Tokyo

Shigeo Maruyama

単層カーボンナノチューブの優れた特性を用いた応用の多くを実現 するためには、最低でも半導体ナノチューブと金属ナノチューブの作り 分けあるいは分離が必要であり、最終的にはカイラリティの決まったナ ノチューブの合成あるいは分離が必要となる.ある程度カイラリティ分 布の狭いナノチューブの合成は実現し、収率を問わなければ金属・半導 体分離やカイラリティ分離の方法も実現しつつあるが、実用的な効率や デバイス上への直接合成をふまえた究極のカイラリティ分離合成につ いては、その方法論さえ存在しない.本講演では、合成されたサンプル から正確にカイラリティ分布を測定するための、共鳴ラマン分光や近赤 外フォトルミネッセンス(PL)分光の基礎的な測定について概観すると ころから初めて、触媒金属の形状や種類、CVD 反応機構の解明と制御に よってカイラリティ分布を制御する試みについて議論する.

カイラリティ制御に先立って、定量的なカイラリティ分布の測定が是 非とも必要であり、共鳴ラマン分光における Kataura プロット[1]の作 成や PL 分光における様々なピークの同定[2,3]、遷移エネルギーに対す

る環境効果の同定[4]などが 必要である. 図1はアルコー ルCVDで合成されたSWNT の典型的な PL マップである. 図中に示したように,フォノ ンサイドバンド[2]やナノチ ューブ軸垂直方向励起吸収 による PL[3]などが観察され る. これらの同定と物理機構 の解は,興味深いとともに, 更積もりのためにも極めて 重要である.また,最近では, 垂直方向励起 PL ピークに対 する環境効果などの実験的



図1PL分光における様々なピーク

検証と理論的な検討を進めて いる.

一方.SWNT の合成機構の解 明に関しては、合成中の吸収や ラマンなどの in-situ 測定と反 応前駆体や反応生成物の詳細 な検討からのアプローチを進 めている. 図2には, 通常のエ ンタノールを用いた垂直配向 膜合成[5]に引き続いて、<sup>13</sup>C 置 換エタノールを用いた合成の 例を示す[6]. 触媒金属における 詳細な反応[7]についても多く の知見が得られつつあり、たと えば、エタノール少量のアセチ レンを加えることで、大幅に合 成速度を増加させることなど も実現している。また、触媒の 制御と併せて、ナノチューブ直 径の制御などが実現しつつある.



図 2 CVD 中の吸収のその場観察と <sup>13</sup>C 同位体エンタノールによる垂直配 向 SWNT 合成

## 文献

[1] P. T. Araujo, S. K. Doorn, S. Kilina, S. Tretiak, E. Einarsson, S. Maruyama, H. Chacham, M. A. Pimenta, A. Jorio, Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 067401-1.

[2] Y. Miyauchi, S. Maruyama, Phys. Rev. B 74 (2006) 35415.

[3] Y. Miyauchi, M. Oba, S. Maruyama, Phys. Rev. B 74 (2006) 205440-1.

[4] Y. Miyauchi, R. Saito, K. Saito, Y. Ohno, S. Iwasaki, T. Mizutani,J. Jiang, S. Maruyama, Chem. Phys. Lett. 442 (2007) 394.

[5] Y. Murakami, E. Einarsson, T. Edamura, S. Maruyama, Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 087402-1.

[6] R. Xiang, Z. Zhang, K. Ogura, J. Okawa, E. Einarsson, Y. Miyauchi, J. Shiomi, S. Maruyama, Jpn. J. Appl. Phys. (2008) in press.

[7] S. Noda, K. Hasegawa, H. Sugime, K. Kakehi, Z. Zhang, S. Maruyama, Y. Yamaguchi, Jpn. J. Appl. Phys. 46 (2007) L399.